

ПОЛИМОРФИЗМ БИПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОЛОСОВЫХ ДОМЕННЫХ СТРУКТУР

Г.В.Арзамасцева, Ф.В.Лисовский¹⁾, Е.Г.Мансветова

Институт радиотехники и электроники РАН

141120 Фрязино, Московская обл., Россия

Поступила в редакцию 9 апреля 1998 г.

Обнаружено индуцируемое магнитным полем явление полиморфизма бипериодических полосовых доменных структур пленок с положительной константой анизотропии и с осью легкого намагничивания, параллельной нормали к поверхности. Выполнена симметрийная классификация наблюдаемых типов доменных структур и определен вид диаграммы состояний пленок на плоскости $(H_{\perp}, H_{\parallel})$, где H_{\perp} и H_{\parallel} – компоненты вектора напряженности магнитного поля, перпендикулярные и параллельные нормали к поверхности.

PACS: 75.70.Kw

Известно, что в одноосных пленках магнетиков с положительной константой анизотропии β_u и с осью легкого намагничивания (ОЛН) вдоль нормали \mathbf{n} к поверхности (далее – ось z) в определенном интервале изменения толщины $L_{cr}^* < L < L_{cr}^{(1)}$, где L_{cr}^* и $L_{cr}^{(1)}$ – некоторые критические значения, в исходной равновесной полосовой доменной структуре (ДС) наблюдаются приповерхностные квазигармонические искажения профиля доменных границ (ДГ), в результате чего распределение вектора намагниченности \mathbf{M} становится бипериодическим (см., например, [1–6]). Подобные структуры вплоть до настоящего времени оставались практически не исследованными.

Нами были изучены ДС одноосных пленок магнитных гранатов состава $\text{Lu}_{2.1}\text{Bi}_{0.9}\text{Fe}_{5-x}\text{Mg}_x\text{O}_{12}$ ($x = 0 \div 0.17$) толщиной $L = 1 \div 40$ мкм, выращенных методом жидкокристаллической эпитаксии (с использованием растворителей Bi_2O_3 или $\text{PbO} - \text{Bi}_2\text{O}_3$) на подложках из $\text{Gd}_3\text{Ga}_5\text{O}_{12}$ с (111)-ориентацией. Режим роста был аналогичен использованному авторами работ [7, 8]. Температура Нееля T_N пленок была равна 560 К, намагниченность насыщения $4\pi M$ составляла 1800 Гс. Для намагничивания образцов до насыщения при $T = 293$ К полями вдоль ($H_{\parallel} = H_z$) и перпендикулярно ($H_{\perp} = H_y$) нормали \mathbf{n} к поверхности требовалось напряженности $H_{\parallel}^* = (1500 \div 1750)$ Э и $H_{\perp}^* = (25 \div 500)$ Э, соответственно. Необходимые поля создавались электромагнитом с двумя парами ортогонально расположенных катушек. Значения константы одноосной анизотропии исследуемых пленок при комнатной температуре находились в пределах $0.72 \div 0.98$. При $H_{\perp} = 0$ в пленках толщиной менее 5 мкм существовала простая (монопериодическая) полосовая ДС с ровными (немодулированными) ДГ, а в более толстых пленках – бипериодическая полосовая ДС с синфазной гармонической приповерхностной модуляцией распределения вектора \mathbf{M} во всех ДГ.

Эксперименты проводились при $T = 293$ К, $H_{\perp} = \text{var}$ и $H_{\parallel} = \text{const}$. При выбранном значении H_{\parallel} устанавливалось насыщающее значение напряженности поля $H_{\perp} > H_{\perp}^*$, затем ток в соответствующей паре катушек электромагнита плавно

¹⁾ e-mail: lisf@dataforce.net

уменьшался до нуля, изменялась полярность тока и пленка опять переводилась в состояние магнитного насыщения полем H_{\perp} противоположного исходному направления. После этого все наблюдения повторялись для восходящей ветви петли гистерезиса. Во всей области существования простых и бипериодических ДС последние были хорошо упорядочены, но содержали дефекты типа свободных и связанных магнитных дислокаций, то есть состояние магнетика соответствовало жидкокристаллической фазе или фазе Березинского – Костерлица – Таулиса [9].

При индуцируемом магнитным полем H_{\perp} фазовом переходе (ФП) из однородно намагниченного состояния в фазу с простой полосовой ДС с периодом d границы между доменами ориентировались параллельно вектору H_{\perp} , то есть характеризовались вектором обратной решетки $\mathbf{b}_1 = (2\pi/d)\mathbf{e}_x$. Для описания бипериодических ДС, помимо d , необходимо использовать еще два параметра: Λ_1 и Λ_2 (в общем случае $\Lambda_1 \neq \Lambda_2$), равные соответственно периодам поверхностной модуляции профиля ДГ на границах раздела пленки со свободным пространством и с подложкой. Пространство векторов обратной решетки при этом становится двумерным, причем $\mathbf{b}_{2i} = (2\pi/\Lambda_i)\mathbf{e}_y$, где $i = 1, 2$.

Распределение намагниченности в ДС любого типа было неоднородным как по толщине, так и в развитых плоскостях пленок. Наблюдения за поведением ДС показали, что область существования бипериодических структур на диаграмме состояний в координатах $(H_{\perp}, H_{\parallel})$ всегда располагается внутри области устойчивости простых полосовых ДС²⁾. В зависимости от предыстории и значений компонент напряженности поля $(H_{\perp}, H_{\parallel})$ реализуется несколько типов бипериодических ДС, которые поддаются симметрийной классификации.

Типичный вид диаграммы состояний для одной из исследованных пленок (№1) толщиной 16 мкм приведен на рис. 1. Кривые ФП 1-го и 2-го родов показаны соответственно сплошными и штриховыми линиями, границы потери устойчивости – штрих-пунктиром, римскими цифрами обозначены различные устойчивые состояния пленки (I – однородно намагниченные состояния, II – простые полосовые ДС, III – VI – бипериодические полосовые ДС). На рис. 1 для состояний III–VI схематически изображены также результаты симметрийной классификации, а именно: мотивообразующие элементы (в виде черно-белых фигур, оконтуренных жирной сплошной линией), доменные границы (штриховые линии) и прямоугольные ячейки Браве (тонкие сплошные линии). Вспомогательные пунктирные линии использованы с целью акцентирования отдельных операций симметрии. Черно-белое представление мотивообразующих элементов символически отображает неоднородное распределение вектора M на любой из двух поверхностей пленки (или в любой параллельной им плоскости): черными показаны области с одним знаком проекции M_z (при любой величине последней), белыми – области с противоположным знаком M_z , а штриховые линии (ДГ) соответствуют множеству точек, где $M_z = 0$. В рамках принятой символики симметрия реализуемых бипериодических ДС описывается одной из шести двумерных пространственных групп прямоугольной сингонии с примитивной ($Pam2$, Pa , $Pmm2$, Pm) или центрированной ($Cmm2$, Cm) ячейкой Браве. Структу-

²⁾ Если толщина пленок $L \rightarrow L_{cr}^* + 0 \simeq 5$ мкм, то область существования доменов с модулированным профилем ДГ стягивается в точку, а амплитуда гармонических искажений профиля ДГ монотонно стремится к нулю.

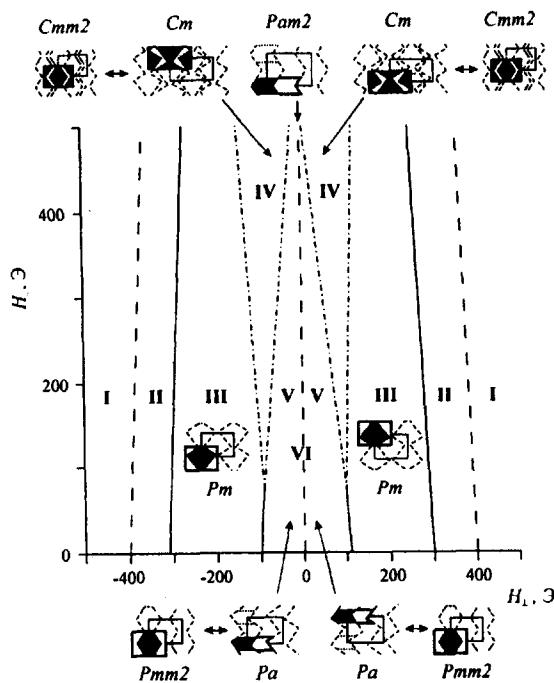


Рис.1. Диаграмма состояний пленки №1 толщиной 16 мкм на плоскости (H_{\perp} , H_{\parallel})

ры с симметрией Pa , Pm и Cm могут существовать в дуальных модификациях, соответствующих двум антипараллельным направлениям вектора \mathbf{H}_{\perp} .

Простейшей является симметричная синфазная бипериодическая ДС (рис.2a) с симметрией, описываемой пространственной группой $Pam2$, реализующаяся при $H_{\perp} = 0$, то есть в области VI на рис. 1. Любое сколь угодно малое поле H_{\perp} переводит такую структуру путем ФП 2-го рода в одну из двух модификаций несимметричной синфазной бипериодической ДС (рис.2b) с симметрией Pa , существующих в областях V на рис. 1. Дальнейшее увеличение напряженности поля H_{\perp} приводит (при $H_{\parallel} < H_{\parallel}^{(cr)} \simeq 70 \text{ Оe}$) к трансформации таких структур в несимметричные³⁾ противофазные бипериодические ДС (рис.2c) с симметрией Pm , существующие в областях III на рис. 1. С ростом H_{\perp} такие структуры переходят (ФП 1-го рода) в простые полосовые (области II на рис. 1).

При $H_{\parallel} > H_{\parallel}^{(cr)}$ в цепочке ФП появляются новые звенья, а именно: трансформация противофазных бипериодических ДС в синфазные бипериодические при изменении H_{\perp} осуществляется через "буферные" ДС (рис.2d) с симметрией Cm , существующие в областях IV на рис. 1. Эти структуры, представляющие собой последовательность чередующихся участков синфазных и противофазных бипериодических ДС и обладающие удвоенным по отношению к соседним фазам периодом $d' = 2d$, можно назвать двойными зеркально-симметричными бипериодическими ДС. Если область

³⁾ Симметричные модификации противофазных ДС могут существовать только при $H_{\perp} = 0$. Такая ситуация может реализоваться в достаточно тонких пленках при большой ширине петли гистерезиса для ФП 1-го рода между состояниями с симметрией Pm и Pa .

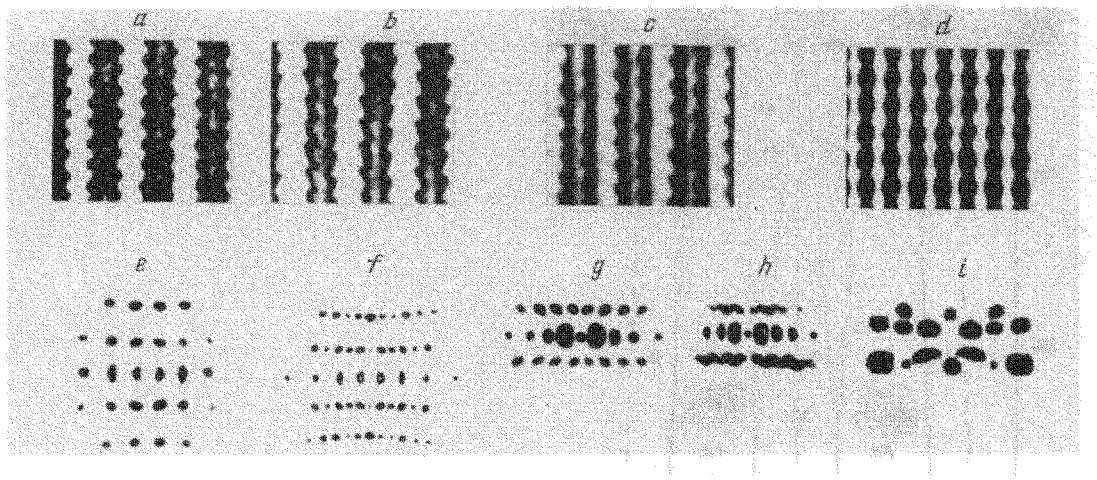


Рис.2. Фотографии некоторых из наблюдаемых ДС (*a–d*) и соответствующих им дифракционных картин (*e–i*) для пленки №1

их существования на диаграмме рис. 1 пересекает ось ординат, то при ($H_{\perp} = 0$) они переходят в двойные бисимметричные бипериодические ДС с симметрией *Cmm2*.

Эволюцию наблюдаемых в эксперименте ДС для пленки №1 при $H_{\parallel} = 0$ и $H_{\perp} = var$ иллюстрирует рис. 3. При старте из области с простой полосовой ДС и снижении напряженности поля H_{\perp} при определенном критическом значении последней на поверхности раздела пленки со свободным пространством скачком происходит формирование противофазной бипериодической ДС (с максимально возможным для данной поверхности периодом модуляции профиля ДГ $\Lambda_1 = \Lambda_{1max}$), которая, судя по виду наблюдаемых дифракционных картин, близка к симметричной. При несколько меньшей напряженности поля аналогичная изгибная неустойчивость ДГ возникает и на границе раздела пленки с подложкой (с минимально возможным для данной поверхности периодом $\Lambda_2 = \Lambda_{2min} < \Lambda_{1max}$). В некоторой области изменения H_{\perp} обе поверхностные структуры существуют независимо и не влияют друг на друга; периоды модуляции профилей ДГ в обеих структурах Λ_1 и Λ_2 остаются практически постоянными. Затем за счет увеличения глубины проникновения модуляции профилей ДГ между поверхностными бипериодическими структурами возникает связь, которая приводит к трансформации противофазной симметричной бипериодической ДС в одну из дуальных модификаций синфазной несимметричной бипериодической ДС. Кроме того, появляется ярко выраженная полевая зависимость периодов модуляции Λ_1 и Λ_2 , скачкообразное изменение и сближение их значений. Затем достигается полная пространственная синхронизация⁴⁾ квазигармонических искажений профиля на обеих поверхностях пленки ($\Lambda_1 = \Lambda_2 = \Lambda$, где $\Lambda_{1min} < \Lambda < \Lambda_{2max}$) и формируется

⁴⁾ В достаточно толстых пленках ($L > \approx 20$ мкм) вообще не происходит формирования единой "синхронизированной" бипериодической ДС: во всем интервале существования наблюдаются две не связанные друг с другом системы ДГ с модулированным профилем, имеющие разные периоды модуляции Λ_1 и Λ_2 , но один и тот же период полосовых доменов d .

единая синфазная несимметричная бипериодическая ДС, сохраняющая устойчивость и при $H_{\perp} = 0$.

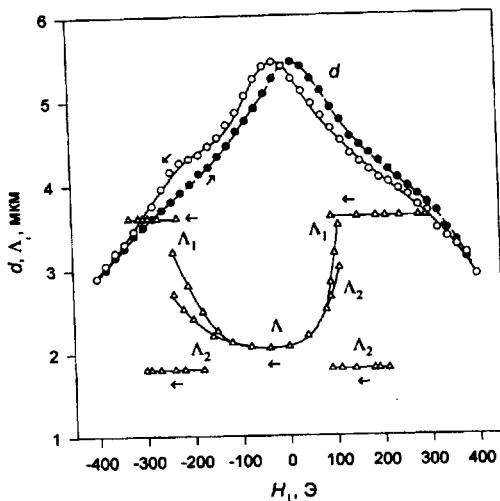


Рис.3. Зависимости геометрических параметров бипериодических полосовых ДС в пленке №1 от напряженности поля H_{\perp}

После изменения знака поля и последующего небольшого (< 5 Э) увеличения его напряженности происходило скачкообразное перемагничивание пленки (изменение знака проекции M_z во всех доменах на первоначальное направление вектора \mathbf{H}_{\perp}), сопровождающееся переходом исходной синфазной несимметричной бипериодической ДС в дуальную модификацию⁵⁾. При увеличении напряженности поля H_{\perp} с противоположным (по отношению к исходному) направлением все процессы протекали сходным образом в обратной последовательности с гистерезисом, характерным для ФП 1-го рода. Процессы зародышеобразования при этом реализовались через магнитные дислокации, которые привносили в исходный доменный массив не только другие значения периодов d и Λ , но и другую локальную симметрию. Фазовые превращения 2-го рода имели место только для переходов между симметричными и несимметричными модификациями синфазных (группы симметрии $Pam2$ и Pa) и противофазных (группы симметрии $Pmm2$ и Pm) бипериодических ДС, но и они при циклическом изменении поля H_{\perp} происходили в несовпадающих интервалах для различных направлений изменения поля из-за того, что полевая зависимость периода d "материнской" полосовой ДС также обладает гистерезисом (см. рис. 3).

Существование различных типов бипериодических ДС подтверждается экспериментами по дифракции света на двумерных доменных массивах. При рассеянии падающего на пленку вдоль оси z света дифракционные максимумы возникают в направлениях $\mathbf{k}_{(p,q)} = \mathbf{k} + p\mathbf{b}_1 + q\mathbf{b}_2$, где \mathbf{k} – волновой вектор первичного светового пучка, p и q – целые числа, а \mathbf{b}_1 и \mathbf{b}_2 – базисные векторы обратной решетки. Симметрийный анализ показывает, что при $\bar{d}_+ = \bar{d}_- = d/2$, где \bar{d}_+ и \bar{d}_- – средняя ширина доменов с $M_z > 0$ и $M_z < 0$, соответственно, для синфазных симметричных бипериодических ДС будет наблюдаться гашение максимумов с $p = 2n$ и любым q (кроме основного дифракционного максимума), а для противофазных симметричных бипе-

⁵⁾ Обратным снижением напряженности поля H_{\perp} до нуля несимметричная синфазная бипериодическая ДС трансформировалась в симметричную.

риодических ДС – гашение максимумов с $p = 2n + 1$ и любым q (кроме максимумов с $(p, q) = (\pm 1, 0)$). При рассеянии света на бипериодических структурах с удвоением периода направления на дифракционные максимумы определяются соотношениями $\mathbf{k}_{(p,q)} = \mathbf{k} + p\mathbf{b}'_1 + q\mathbf{b}_2$, где $\mathbf{b}'_1 \simeq \mathbf{b}_1/2$, а \mathbf{b}_1 – соответствующий вектор обратной решетки для породившей данную двойную бипериодическую ДС "материнской" синфазной или противофазной структуры. Для бисимметричных двойных бипериодических ДС наблюдается гашение всех дифракционных максимумов с $p = 2n$ и любым $q \neq 0$, где $|n| \geq 1$; для зеркально-симметричных двойных бипериодических структур этого не происходит.

Негативные фотографии наблюдаемых в экспериментах дифракционных картин для пленки №1 приведены на рис.2e – i. Снимки e и f соответствуют симметричной и несимметричной синфазной бипериодической ДС, снимок g – двойной зеркально-симметричной, снимок h – сосуществованию синфазной несимметричной и двойной зеркально-симметричной и снимок i – сосуществованию синфазной несимметричной и противофазной симметричной бипериодической ДС (в последнем случае для устранения засветки заэкранированы центральный дифракционный максимум и нижняя часть дифракционной картины). Вид реально наблюдаемых дифракционных картин хорошо соответствует результатам качественного симметрийного анализа.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, код проекта 96-02-16082-а.

-
1. W.S.Paxton and T.G.Nilan, J. Appl. Phys. **26**, 65 (1955).
 2. Х.Вильямс, Р.Шервуд, в сб.: *Магнитные свойства металлов и сплавов*, пер. с англ., М.: ИЛ, 1961, с. 61.
 3. J.Kaczer and R.Gemperle, Czech. J. Phys. **B11**, 157 (1961).
 4. Г.С.Кандаурова, Изв. ВУЗов, физика **5**, 12 (1964).
 5. Л.С.Палатник, Л.И.Лукашенко, Ю.В.Золотницкий и др., ЖЭТФ **59**, 1177 (1970).
 6. С.Тикадзуми, *Физика ферромагнетизма: Магнитные характеристики и практические применения*, М.: Мир, (1987).
 7. H.Tamada and M.Kaneko, T.Okamoto, J. Appl. Phys. **64**, 554 (1988).
 8. H.Huahui, S. Jan, D.Hanming et al., IEEE Trans. on Magnetics **25**, 3497 (1989).
 9. И.Е.Дикштейн, Ф.В.Лисовский, Е.Г.Мансветова и др., ЖЭТФ **86**, 1473 (1984).